

بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات فریت با ترکیب $Cu_{1-x}Co_xFe_2O_4$ (x=0-1) تولید شده به روش مايسل معکوس

ابراهیم قاسمی^۱، علی قاسمی^۲ و ابراهیم پایموزد^{*}

۱- عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

۲- استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

۳- کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

*Paimozd@gmail.com

(تاریخ دریافت: ۸۹/۰۶/۱۱، تاریخ پذیرش: ۸۹/۰۸/۲۵)

چکیده

در این پژوهش نانوذرات فریت $Cu_{1-x}Co_xFe_2O_4$ با استفاده از فرآیند مايسل معکوس تهیه شد. الگوی تفرق اشعه X نشان داد که محصول تولیدی تکفاز فریت اسپینلی می‌باشد. نتایج به دست آمده از آزمون مغناطیس سنج ارتعاشی ثابت کرد که با افزایش مقدار کبالت، مغناطیس اشباع افزایش می‌یابد. ارتباط ترکیب شیمیایی با دمای بلوکه با استفاده از تجهیزات ابررسانایی اسکوئید اندازه گیری شد. دینامیک مغناطیس نمونه‌ها با اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی AC بر حسب دما در فرکانس‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مدل‌های نیل-برون و وُگل - فولچر برای تشخیص برهمکنش و یا عدم برهمکنش ذرات به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که برهمکنش قوی بین ذرات بسیار ریز وجود دارد.

واژه‌های کلیدی:

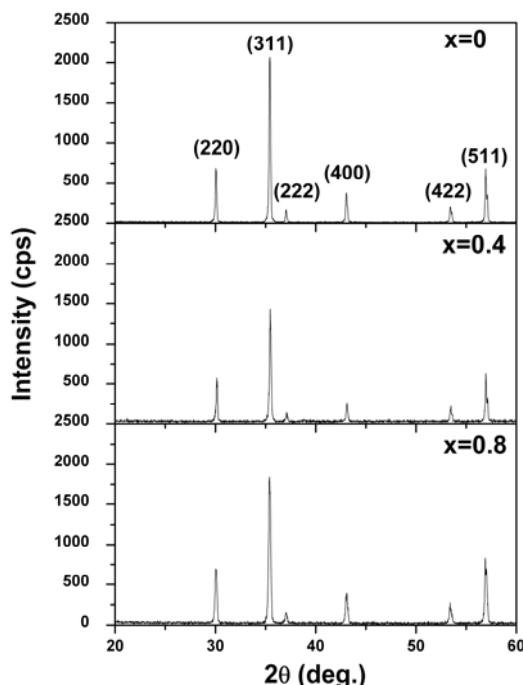
فریت، مايسل معکوس، خواص مغناطیسی.

دارای ساختار اسپینلی می‌باشد و به دلیل مقاومت الکتریکی بالا،

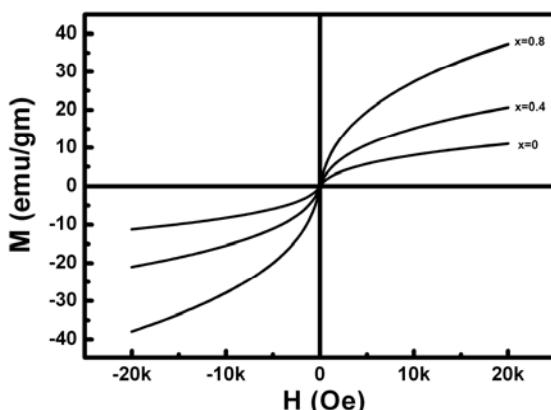
خواص مکانیکی مناسب، نقطه کوری بالا و پایداری در محیط به طور وسیعی در بسیاری از وسایل الکترونیکی استفاده می‌شود. طبق مطالعاتی که انجام گرفت مشخص گردید که اطلاعاتی در مورد تهیه این فریت با روش مايسل معکوس گزارش نشده است. با توجه به این مطالب، نانوذرات فریت $Cu_{1-x}Co_xFe_2O_4$ با استفاده از تکنیک مايسل معکوس در دمای پایین تهیه شد و

۱- مقدمه

مطالعات زیادی روی تهیه و بررسی خصوصیات مغناطیسی نانوذرات فریت انجام شده است [۱-۵]. رسوب گذاری در روش مايسل معکوس، تکنیک بسیار مناسبی برای تهیه نانوذرات با توزیع اندازه یکنواخت در دمای پایین می‌باشد. مقالات متعددی در مورد سنتز فریت نیکل-روی و فریت منگنز-روی با روش مايسل معکوس وجود دارد [۶-۱۰]. فریت $Cu_{1-x}Co_xFe_2O_4$ فریت



شکل (۱): الگوی پراش پرتو X نانوذرات ستتر شده به روش مایسل معکوس.



شکل (۲): منحنی های VSM نمونه های فریت تهیه شده.

میدان پسماندزدا و مغناطش باقیمانده برای نمونه ها تقریباً صفر است. این نمونه ها حتی با اعمال میدان مغناطیسی ۲۰ kOe به اشباع نمی رساند که این موضوع به علت خصوصیات سوپرپارا مغناطیس بودن ذرات است. مقدار مغناطش اشباع به دست آمده، توسط رابطه $M = M_s(1 - \alpha/H)$ تعیین شد که M و M_s به ترتیب مغناطش و مغناطش اشباع می باشند. α ثابت رابطه و H میدان اعمالی است. جدول (۱) میزان مغناطش اشباع محاسبه

خصوصیات ساختاری و مغناطیسی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

۲- مواد و روش تحقیق

نانوذرات $Cu_{1-x}Co_xFe_2O_4$ توسط فرآیند مایسل معکوس تولید شد. به این منظور از دو سیستم میکروامولسیون که اولی شامل ترساز AOT/۵M، ایزواکتان و هیدروکسید آمونیم همراه آب و سیستم دوم محلول آبی حاوی نمک های فلزی، ترساز AOT/۵M و ایزواکتان استفاده شد. این نانوذرات با استفاده از دستگاه دیفرکتو متر اشعه X فیلیپس با تابش $Cu k\alpha$ و مشخصات (۵۰ kV، ۳۰ mA) تحت آزمون پرتو X قرار گرفتند. مشخصه یابی مورفولوژی و توزیع اندازه ذرات نمونه های تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM مدل JEOL ۲۰۱۰ انجام گردید. مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی VSM برای بررسی تغییرات مغناطیسی استفاده شد. ارتباط دمایی پذیرفتاری مغناطیسی و مغناطش نانوذرات تحت میدان اعمالی ۱۱۵ Oe توسط پذیرفتار سنج مغناطیسی مدل SQUID Lake Shore ۷۰۰۰ و تجهیزات ابرسانانی اسکوئید انجام شد. در این مورد پس از سرد کردن نمونه بدون اعمال میدان (ZFC)، میدان ۱۱۵ Oe اعمال گردید.

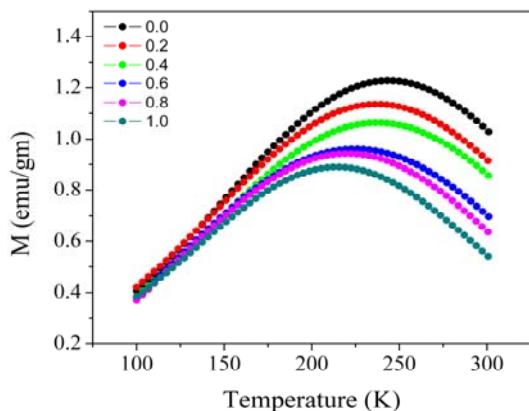
۳- نتایج و بحث

۳-۱- آنالیز ساختاری و مغناطیسی

الگوی پراش پرتو X در شکل (۱) نشان می دهد که مس در ساختار کریستالی نمونه ها جایگزین کجالت شده و هیچ پیک اضافی مربوط به فاز ثانویه در آن ها وجود ندارد. بر اساس نتایج XRD به نظر می رسد کاتیون های مس می توانند نظم مجددی در ساختار اسپینلی فریت ایجاد کنند. توزیع اندازه ذره بر اساس آنالیز تصاویر زمینه روشن نانوذرات، تخمین زده شد. اندازه نانوذرات با محاسبه ۱۰۰ ذره در چندین تصویر به دست آمد. مشخص شد که اندازه ذرات در محدوده ۵-۱۵ nm می باشند. شکل (۲) منحنی VSM نانوذرات به دست آمده را نشان می دهد.

جدول (۱): تغییرات میدان پسماندزدای مغناطیسی، مغناطش اشباع و محدوده اندازه نانوذرات تهیه شده.

	X = ۰	X = ۰ / ۲	X = ۰ / ۴	X = ۰ / ۶	X = ۰ / ۸	X = ۱
M_s (emu/g)	۱۶	۲۳	۳۳	۳۹	۴۶	۵۱
H_c (Oe)	۰/۰۲	۰/۰۴	۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۶	۰/۰۵
Particles Size (nm)	۵-۱۰	۷-۱۲	۱۳-۱۷	۱۵-۲۳	۲۰-۲۷	۲۵-۳۰



شکل (۳): منحنی های ZFC نمونه ها که با تجهیزات SQUID به دست آمده است.

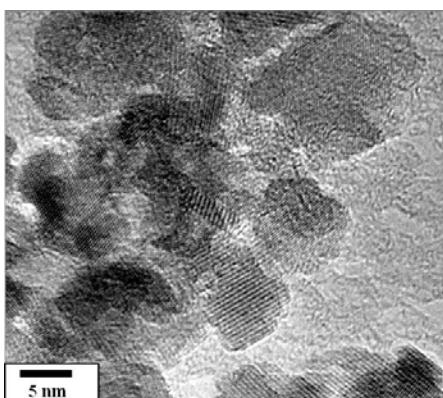
انرژی حرارتی نانوذرات افزایش یافته و گشتاور مغناطیسی هر ذره تابع میدان اعمالی می شود. بنابراین مغناطش افزایش می یابد. در دماهای بالاتر از T_B ، انرژی حرارتی بر انرژی ناهمسانگردی غلبه می کند و مغناطش هر تک ذره شروع به چرخش پیوسته می کند. در نتیجه نانوذرات سوپر پارامغناطیس می باشند. برای مطالعه رفتار دینامیک مغناطیسی، پذیرفتاری مغناطیسی AC نانوذرات فریت تهیه شده بر حسب دما در فرکانس های مختلف اندازه گیری شد. شکل (۴) وابستگی دمایی قسمت حقیقی و مجازی پذیرفتاری مغناطیسی نمونه $x=1$ در محدوده فرکانس $111-1000$ Hz و در میدان مغناطیسی AC با شدت میدان $x=1$ ۱۱۵ Oe را نشان می دهد. در شکل (۵) تصویر TEM نمونه $x=1$ ۱۱۵ Oe نیز مشخص می باشد. محدوده اندازه ذره بر اساس مشاهدات TEM حدود 10 nm -۵ است. در شکل (۴)، مقدار موهوسی پذیرفتاری مغناطیسی $(T)^{\alpha}$ یک پیک نزدیک دمای K ۲۲۵ دارد که به فرکانس وابسته بوده و با افزایش فرکانس به دماهای بالاتر منتقل می شود. این مقدار ماکریم، اثر فرآیند بلوکه

شده را نشان می دهد.

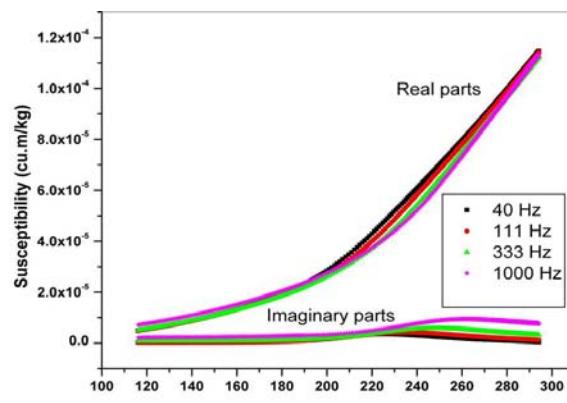
کمتر بودن مقدار مغناطش اشباع فریت نانوکریستال تهیه شده به روش مایسل معکوس، مربوط به اثرات سطح ذره است که به ناموزی بودن گشتاور مغناطیسی روی سطح آن منجر می شود و می تواند با مدل پوسته - هسته برای نانوذرات توضیح داده شود به این صورت که هسته شامل اسپین ردیف شده با نظم فری مغناطیس می باشد و اسپین های فصل مشترک یا سطح نسبت به اسپین های داخل هسته می چرخند و موجب کاهش مغناطش اشباع فریت نانوذره می شوند. بی نظمی در پوسته به سبب بی نظمی موضعی ترکیب شیمیایی، تخریب باندهای تبادل شده و تفاوت تقارن موضعی برای اتم های نزدیک سطح می باشد.

۲-۳- برهمنکش یا عدم برهمنکش نانوذرات

شکل (۳) وابستگی دمایی مغناطش به دست آمده با یک میدان اعمالی ۱۱۵ Oe را پس از سرد کردن نمونه بدون اعمال میدان (ZFC)، از دمای 100 K تا 300 K نشان می دهد. یک ماکریم در منحنی های ZFC برای دمای بلوکه وجود دارد. مشاهده می شود که افزایش کیالت، باعث افزایش دمای بلوکه می شود. از آنجایی که دمای بلوکه با اندازه ذره مرتبط است، افزایش در دمای بلوکه می تواند مربوط به افزایش اندازه ذره باشد. در دمای کمتر از دمای بلوکه، در حالتی که میدان اعمالی وجود نداشته باشد، چون گشتاور مغناطیسی هر ذره در جهت آسان قرار می گیرد. هر ذره گشتاور مغناطیسی خاص خود را دارد و ذرات گشتاورهای همیگر را خشی می کنند و مغناطش بسیار کوچک می شود. بنابراین مغناطش کل در 100 K کم است. بایستی توجه کرد که میدان اعمال شده ضعیف می باشد (115 Oe) و توانایی غلبه بر سد ناهمسانگردی را ندارد. با افزایش دما بالاتر از 100 K،



شکل (۵): میکروگراف TEM برای نمونه ۱



شکل (۴): تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی مؤثر نسبت به تغییر دما.

آزمایش پذیرفتاری مغناطیسی نمونه‌ها با معادله (۲) منطبق است و مشخص شد که ثابت زمانی در گستره $2/3 \times 10^{-5} \text{ s}$ تا $3/8 \times 10^{-9} \text{ s}$ می‌باشد. توافق بین اطلاعات آزمایشی و مدل وگل-فولچر، وجود برهمکنش قوی بین نانوذرات را تصدیق می‌کند.

شدن/میخکوب شدن^۲ سیستم سوپر پارامغناطیس / اسپین گلس^۳ پراکنده شدن بسیار بی نظم اسپین‌ها) می‌باشد [۱۵-۱۱]. رفتار برهمکنش یا عدم برهمکنش ذرات توسط مدل‌های نیل-برون^۴ (مدل عدم برهمکنش) و وگل-فولچر^۵ (قانون برهمکنش) ارزیابی شد. در مدل نیل-برون، دمای بلوکه اندازه‌گیری شده، با فرکانس به صورت زیر مرتبط می‌باشد:

$$\ln(\frac{1}{2\pi\nu}) = \ln\tau_0 + Kv/kT_B \quad (1)$$

نانوذرات تک‌فاز $\text{Cu}_{1-x}\text{Co}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ به وسیله روش مایسل معکوس تهیه شد. دمای بلوکه شدن، دارای نسبت مستقیم با اندازه ذره می‌باشد. وابستگی دمایی قسمت‌های حقیقی و مجازی پذیرفتاری مغناطیسی مؤثر اندازه‌گیری شد و همخوانی خوب بین اطلاعات پذیرفتاری مغناطیسی و مدل وگل-فولچر حضور برهمکنش قوی بین نانوذرات را تأیید نمود.

۴- نتیجه‌گیری

T_B به وسیله بیشترین مقدار قسمت موهومند پذیرفتاری مغناطیسی به دست می‌آید [۱۶]. ثابت زمانی که از تطابق معادله (۱) با نتایج به دست آمد، در محدوده $10^{-21}-10^{-33} \text{ s}$ می‌باشد. این مقادیر فیزیکی نمی‌باشند و چندین برابر کمتر از مقادیر مشخص شده برای نانوذرات سوپر پارامغناطیس است ($10^{-11}-10^{-10} \text{ s}$) [۱۱]. این موضوع نشان می‌دهد که مدل نیل-برون برای تشریح رفتار دینامیکی این سیستم مناسب نمی‌باشد. در این حالت انحراف از مدل می‌تواند با حضور برهمکنش‌های قوی توضیح داده شود. برهمکنش بین نانوذرات روی دمای بلوکه شدن اثر گذاشته و با افزایش شدت برهمکنش، دمای بلوکه شدن یا T_B به دماهای بالاتر می‌رود. در حالتی که نانوذرات با یکدیگر برهمکنش‌های مغناطیسی دارند، طبق قانون وگل-فولچر فرکانس تابعی از T_B می‌باشد:

$$\ln(\frac{1}{2\pi\nu}) = \ln\tau_0 + E_a / k(T - T_B) \quad (2)$$

- [1] A. Ghasemi, V. Šepelák, X. X. Liu, A. Morisako, J. Appl. Phys. Vol. 107, pp. 09A734-09A737, 2010.
- [2] A. Ghasemi, V. Šepelák, X. X. Liu, A. Morisako, J. Appl. Phys. Vol. 107, pp. 09A743-09A746, 2010.
- [3] A. Ghasemi, V. Šepelák, X. Liu, A. Morisako, IEEE Trans. Magn. Vol. 45, pp. 2456-2460, 2009.
- [4] A. Ghasemi, X. Liu, A. Morisako, IEEE Trans. Magn. Vol. 45, pp. 4420-4424, 2009.
- [5] A. Ghasemi, A. Morisako, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 320, pp. 1167-1172, 2008.
- [6] S. Thakur, S. C. Latyal, M. Singh, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 321, pp. 1-7, 2009.

۵- مراجع

سد انرژی، T_0 دمای مؤثر که وجود برهمکنش بین نانوذرات را آشکار می‌کند و T دمای فرآیند را نشان می‌دهد. اطلاعات

- [15] S. Vasseur, E. Duguet, J. Portier, G. Goglio, S. Mornet, E. Hadová, K. Knížek, M. Maryško, P. Veverka, E. Pollert, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 302, pp. 315-320, 2006.
- [16] G. F. Goya, T. S. BerquÓ, F. C. Fonseca and M. P. Morales, J. Appl. Phys. Vol. 94, pp. 3520-3529, 2003.
- ۶- پی‌نوشت
- 1- Vibration Sample Magnetometer
 2- Blocking / Freezing Process
 3- Superparamagnetic / Spin Glass Systems
 4- Néel – Brown
 5- Vogel – Fulcher
- [7] V. Uskokovic, M. Drofenik, I. Ban, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 284, pp. 294-302, 2004.
- [8] M. D. Shultz, M. J. Allsbrook, E. E. Carpenter, J. Appl. Phys. Vol. 101, pp. 518-521, 2007.
- [9] S. A. Morrison, C. L. Cahill, E. E. Carpenrer, S. Calvin, R. Swaminathan, M. E. McHenry, V. G. Harris, J. Appl. Phys. Vol. 95, pp. 6392-6396, 2004.
- [10] S. A. Morrison, C. L. Cahill, E. E. Carpenrer, S. Calvin, V. G. Harris, J. Appl. Phys. Vol. 93, pp. 7489-7492, 2003.
- [11] J. L. Dormann, D. Fiorani, D. Tronc, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 202, pp. 251-267, 1999.
- [12] P. E. Jönsson, Adv. Chem. Phys. Vol. 128, pp. 191-248, 2004.
- [13] M. Suzuki, S. I. Fullem and I. S. Suzuki, Phys. Rev. Vol. B 79, pp. 024418-024425, 2009.
- [14] D. Parker, V. Dupuis, F. Ladieu, J. P. Bouchaud, E. Dubois, R. Perzynski, E. Vincent, Phys. Rev. Vol. B77, pp. 104428-104437, 2008.